

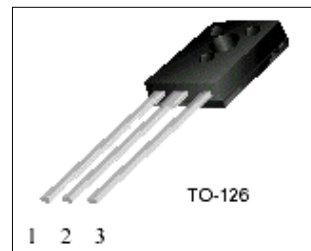
**КТ972А, Г**

**NPN КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ ВЧ СОСТАВНОЙ ТРАНЗИСТОР**

**оАО. 336.452 ТУ**

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В АППАРАТУРЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

- \* Зарубежный аналог КТ872А – **BD875**
- \* Изготавливается в корпусе **КТ-27 (ТО-126)**
- \* Комплементарная пара – **КТ973 А, Г**



**1 - эмитт. 2 -колл. 3 – база**

**ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры	Обозначение	Ед измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	КТ972А, В, Г КТ972Б	Uкб max	В 60 45
Напряжение коллектор-эмиттер (Rбэ = 1 кОм)	КТ972А, В, Г КТ972Б	Uкэг max	В 60 45
Напряжение эмиттер-база		Uэб max	В 5
Постоянный ток коллектора		Iк max	А 2
Импульсный ток коллектора (tu ≤ 10 мкс, Q ≥ 5)		Iки max	А 4
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Tкорп. = -45 ÷ +25 °С		Pк max	Вт 8
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Tсреды. = 25 °С		Pк max	Вт 1.25
Температура перехода		Tj max	°С 150

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Tокр.ср.=25°С )**

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Мин	Мак
Обратный ток коллектор-эмиттер	КТ972А, В КТ972Б, КТ972Г	Iкэг	мА	Uкэ = 60В, Rэб = 1 кОм Uкэ = 45В, Rэб = 1 кОм Uкэ = 60В, Rэб = 1 кОм	1.0 1.0 0.3
Статический коэффициент передачи тока	КТ972А, Б КТ972В, Г	h <sub>21E</sub>		Uкб = 3 В, Iэ = 1 А, f = 50 Гц	750 750 5 000
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	КТ972А, Б, В КТ972Г	Uкэ(нас)	В	Iк = 500 мА, Iб = 50 мА	1.5 0.95
Напряжение насыщения база-эмиттер	КТ972А, Б, В КТ972Г	Uбэ(нас)	В	Iк = 500 мА, Iб = 50 мА	2.5 1.7
Время -рассасывания		трас.	нс	Iб1= Iб2= 50 мА, Q ≥ 50 Iк = 500 мА, ти=30 мкс,	200

**220108, г.Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"**

**Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32**

**E-mail: [market@transistor.com.by](mailto:market@transistor.com.by) <http://www.transistor.by>**